

e) le gaz utilisé est l' H_2 (Hydrogène), pour maintenir le ^{Epitaxia} (2) réacteur propre (N_2 circule à la température $< 300^\circ C$), le gaz H_2 est le gaz porteur puisqu'il ramène le $SiCl_4$ dans le réacteur épitaxial.

f) Dans le MBE (Epitaxie par Jet Moléculaire), la croissance se fait à l'ultra-vide UHV 10^{-9} Torr avec des pompes primaires (roots) et des pompes secondaires (Diffusion, ionique ou turbomoléculaire), les pompes secondaires peuvent atteindre un vide de 10^{-10} à 10^{-12} Torr.

g) Le libre parcours moyen est la distance que parcourt une particule avant la collision. Dans le vide très poussé 10^{-9} Torr, le libre parcours moyen peut atteindre des kilomètres.

h) La mesure de résistivité se fait par la biais de la technique des 4 points.

i) L'instrument de mesure de température du suscepteur est le pyromètre.

j) Les sources de Silicium pour le CVD sont le $SiCl_4$, $SiHCl_3$, SiH_2Cl_2 c'est-à-dire les Chlorures de Silicium.

k) Les sources de dopant à utiliser pour la croissance de couche de type n et p sont la phosphine PH_3 et le Borane (B_2H_6) respectivement, pour le type n As_2H_3 (Arsine) est également utilisé.

l) par "groove" ou fente et contraste chimique entre les zones n et p et mesure de franges par microscope sans lumière monochromatique.